

1	Dépôt par pulvérisation face arrière (FAR) avec recuit	TiPtAu (50/70/200 nm)	etch in situ pré dépôt	recuit 450°C 3s < à T épitaxie	10.05
2	Litho "Métal", dépôt lift-off	résine Z5214 négative	NiGeAu (200/20/5 nm)	masque en quartz	BCAI
3	Désoxydation ex-situ avant dépôt	Bain HCl-10%		30 s	BCAI
4	Dépôt par évaporation	tricouche : NiGeAu (5/20/200 nm) pentacouche : NiGeAuNiAu (10/100/20/5/200 nm)	tester avec et sans flash Ar avant dépôt (= phase amorphe dans InGaAs)	395°C 90s	BCAI
5	Lift off et nettoyages				
6	Litho	résine Z1512 positive	définir les MESAs		
7	RIE gravure MESA		épaisseur à graver : plasma, IBE ? (Attention aux flancs)	Plasma préféré (à voir)	
8	Strip résine et nettoyage plaque				